

学振「結晶加工と評価技術」第145委員会
第133回研究会のプログラム

日時：2013年2月21日（木）13:00～17:30

会場：研究会、明治大学 駿河台キャンパス 大学会館（8階）第3・4会議室
懇親会、同大学会館3階 第2会議室（17:30～19:30）

テーマ 「イオン注入技術とその欠陥制御

世話人：豊田 紀章（兵庫県立大学）、小椋 厚志（明治大学）、松本 智（慶應大学）

プログラム

- 13:00～13:05 はじめに 松本 智
- 13:05～13:50 「半導体先端デバイスにおけるイオン注入技術と欠陥制御」
（株）東芝 須黒 恭一
- 13:50～14:35 「イメージセンサーデバイスにおける微量欠陥の影響と評価」
パナソニック（株） 柴田 聡
- 14:35～15:20 「最新イオン注入装置と新材料への応用」
日新イオン機器（株） 丹上 正安
- 15:20～15:40 休憩
- 15:40～16:25 「シングルイオン注入技術」
産業技術総合研究所 品田 賢宏
- 16:25～17:10 「陽電子消滅法による半導体欠陥評価」
筑波大学 上殿 明良
- 17:10～17:15 おわりに 小椋 厚志
- 17:15～17:30 総会、その他
- 17:30～19:30 懇親会（場所：大学会館3階 第2会議室）
以上